



LYCS1P60 型 P 沟道 MOS 场效应晶体管

1 特性

- 开关速度快, 输入阻抗高; 安全工作区宽, 温度稳定性好;
- 静电敏感等级: 1B;
- 封装形式: A3-02B。



A3-02B 型



SOT-223C

SO-8C

2 质量等级及执行标准

G 级: QZJ840611, Q/RBJ1005QZ。

3 最大额定值

最大额定值见表 1, 除另有规定外, $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

参数 产品型号	P_D (W)	BV_{DSS} (V)	V_{GS} (V)	I_{DM1} ($T_c=25^\circ\text{C}$) A	I_{DM2} ($T_c=100^\circ\text{C}$) A	$R_{th(j-C)}$ (°C/W)	T_j (°C)	T_{stg} (°C)	封装形式
LYCS1P60	63 ^a					2			A3-02B
LYCS1P60		-60	± 20	-1.6			-55~150	-55~150	SOT-223C
LYCS1P60	15 ^b				-1.2	8			SO-8C

^a当 T_c 超过 25°C 时, 按 $0.51\text{W}/\text{°C}$ 线性降额, ^b当 T_c 超过 25°C 时, 按 $0.12\text{W}/\text{°C}$ 线性降额。

4 主要电特性

主要电特性 (除非另有规定外, $T_A=25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$) 见表 2。

表 2 主要电特性

序号	参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
				最小值	典型值	最大值	
1	漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=-250\mu\text{A}$	-60	—	—	V
2	零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=-48\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	—	—	-1	μA
3	正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=-20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	—	-100	nA
4	反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	—	100	nA
5	开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$	-1.0	—	-3.5	V
6	导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=-1.6\text{A}$	—	—	330	$\text{m}\Omega$
7	开启延迟时间	$t_{d(ON)}$		—	12	—	ns
	上升时间	t_r	$V_{DD}=-30\text{V}, V_{GS}=-10\text{V}, I_D=-1.6\text{A}, R_g=1\Omega$	—	15	—	ns
	关断延迟时间	$t_{d(OFF)}$		—	25	—	ns
	下降时间	t_f		—	20	—	ns
8	电容	C_{ISS}	$V_{DS}=20\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	—	780	—	pF
		C_{DSS}		—	53	—	pF
		C_{RSS}		—	38	—	pF
9	电荷	Q_g	$V_{GS}=10\text{V}, V_{DS}=4.5\text{V}, I_D=3\text{A}$	—	6	—	nC
		Q_{gs}		—	3	—	nC
		Q_{gd}		—	2	—	nC



5 特性曲线

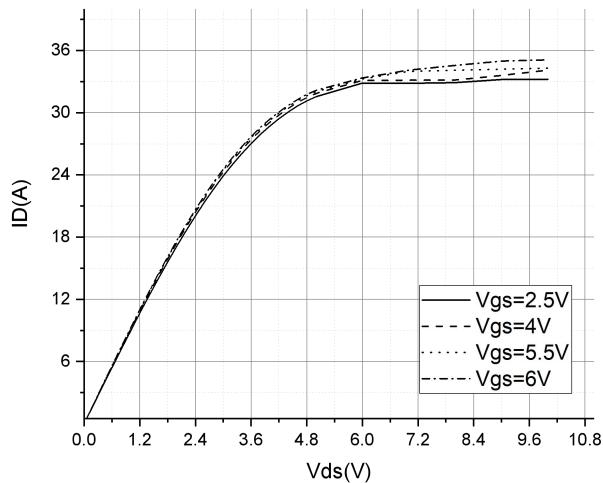


图 1 输出特性曲线

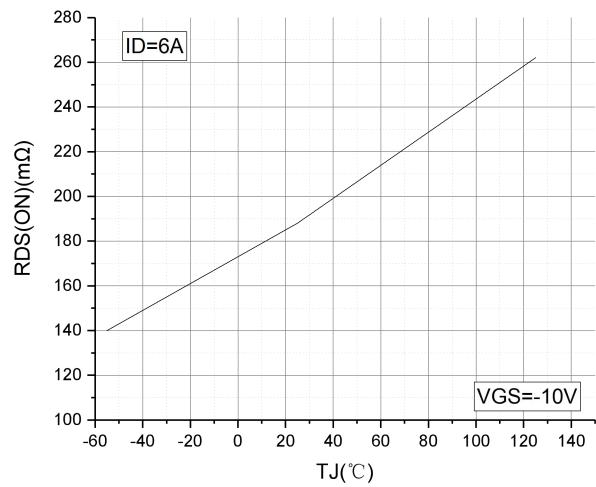
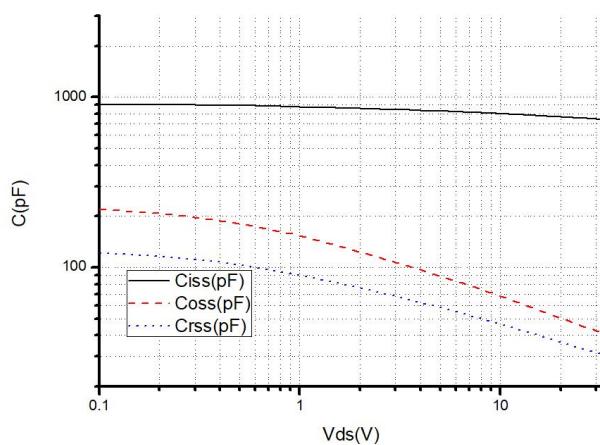
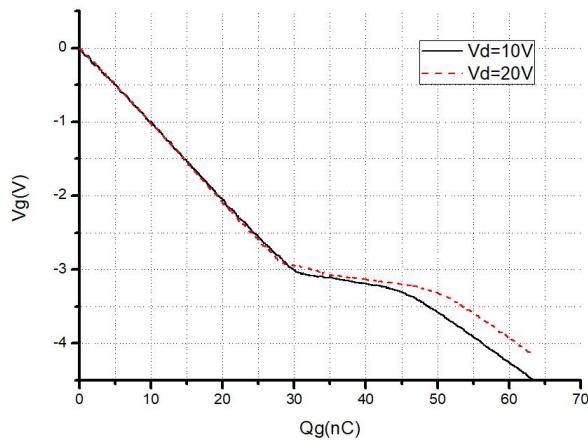
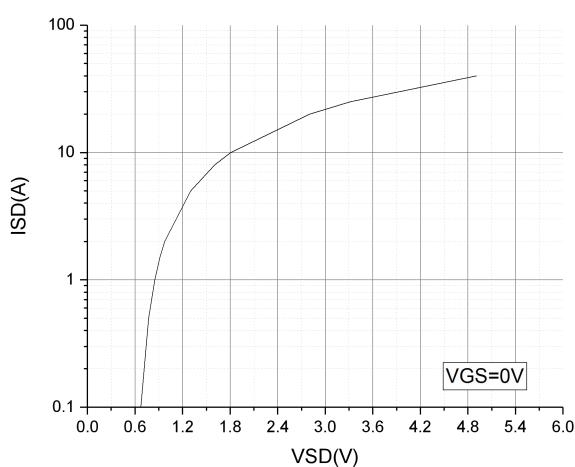
图 2 $R_{DS(on)}$ – T_J 曲线图 3 C – V_{ds} 特性曲线图 4 V_{gs} – Q_g 特性曲线

图 5 体二极管特性曲线

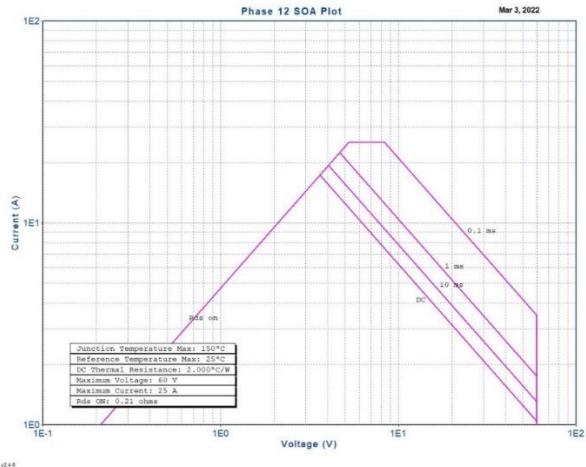


图 6 安全工作区曲线